**Дорошевич Виктор Казимирович**

Сведения об оппоненте:

Рабочий адрес: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 788-09-48

E-mail: dvk1964@list.ru

Название организации: Акционерное общество «РТИ»

Должность: начальник отдела РИУС

Ученая степень, шифр специальности: доктор технических наук по специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции»

Перечень публикаций:

1. Дорошевич В.К., Дорошевич П.В. «Определение оптимального состава отбраковочных испытаний пластин и микросхем» // Наукоемкие технологии. 2012. Т. 13. № 4. С. 40-44.

2. Дорошевич В.К. «Порядок проведения физико-технической экспертизы при оценке качества микросхем» // Наукоемкие технологии. 2012. Т. 13. № 4. С. 44-51.

3. Дорошевич В.К., Дорошевич К.К. «Исследование влияния технологических операций на качество микросхем» // Наукоемкие технологии. 2013. Т. 14. № 2. С. 013-014.

4. Дорошевич В.К. «Исследование влияния качества материалов на качество микросхем» // Наукоемкие технологии. 2013. Т. 14. № 2. С. 015-017.

5. Дорошевич В.К., Дорошевич П.В. «Определение возможности уменьшения планов контроля для функционально сложных микросхем» // Наукоемкие технологии. 2013. Т. 14. № 2. С. 018-020.

6. Дорошевич В.К., Марин В.П., Дорошевич П.В. «Исследование факторов, влияющих на качество микросхем» // Качество и жизнь. 2015. № 2 (6). С. 53-57.

7. Дорошевич В.К., Горбунов В.В. «Применение современных информационных технологий при выборе электрорадиоизделий отечественного и иностранного производства для вновь разрабатываемых и модернизируемых изделий военной техники, а также при сопровождении уже примененной в изделиях военной техники номенклатуры электрорадиоизделий» // Наукоемкие технологии. 2016. Т. 17. № 9. С. 15-19.

**Васильевский Иван Сергеевич**

Сведения об оппоненте:

Рабочий адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Телефон: +7 (495) 788-56-99, доб. 8170

E-mail: [ivasilevskii@mail.ru](mailto:ivasilevskii@mail.ru)

Название организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный ядерный университет «МИФИ»

Должность: доцент кафедры № 67 "Физика конденсированных сред"

Ученая степень, шифр специальности: кандидат физико-математических наук по специальности01.04.09 «Физика низких температур»

Перечень публикаций:

1. Г. Б. Галиев, С. С. Пушкарев, И. С. Васильевский, О.М. Жигалина, Е. А. Климов, В.Г. Жигалина, Р. М. Имамов. «Исследование влияния напряженных сверхрешеток, введенных в метаморфный буфер, на электрофизические свойства и атомное строение наногетероструктур InAlAs/InGaAs МНЕМТ» // ФТП, том 47, вып. 4, стр. 510-515 (2013)
2. G. B. Galiev, I. S. Vasil’evskii, S.S. Pushkarev, E. A. Klimov, R. M. Imamov, P. A. Buffat, B. Dwir, E. I. Suvorova; "Metamorphic InAlAs/InGaAs/InAlAs/GaAs HEMT heterostructures containing strained superlattices and inverse steps in the metamorphic buffer" // Journal of Crystal Growth, 366, p. 55-60 (2013)
3. Г. Б. Галиев, С. С. Пушкарев, И. С. Васильевский, Е. А. Климов, Р. М. Имамов; «Исследование свойств новых конструкций метаморфного буфера InAlAs на подложках GaAs с распределенной компенсацией упругих деформаций», ФТП, т. 47, вып. 7, стр. 990-996 (2013)
4. Г. Б. Галиев, С. С. Пушкарев, И. С. Васильевский, Е. А. Климов, А.Н. Клочков, П.П. Мальцев; «Влияние разориентации подложки (100) GaAs на электрофизические параметры и морфологию поверхности метаморфных НЕМТ наногетероструктур In0.7Al0.3As/In0.7Ga0.3As/In0.7Al0.3As», ФТП, т. 48, вып. 1, стр. 67-72 (2014)
5. И. С. Васильевский, А.Н. Виниченко, М. М. Грехов, В. П. Гладков, Н. И. Каргин, М. Н. Стриханов; «Технология и электронные свойства P-HEMT   
   AlGaAs/Iny(z)Ga1-y(z)As/GaAs квантовых ям с переменным профилем состава», ФТП, т. 48, вып. 9, стр. 1258-1264 (2014)
6. G. B. Galiev, I. S. Vasil’evskii, E. A. Klimov, S.S. Pushkarev, Klochkov A.N., Mal’tsev P.P., M.Yu. Presniakov, I.N. Trunkin, A.L. Vasiliev; «Effect of (100) GaAs substrate misorientation on electrophysical parameters, structural properties and surface morphology of metamorphic HEMT nanoheterostructures InGaAs/InAlAs», Journal of Crystal Growth, Vol. 392, p. 11-19 (2014)
7. Ю.Г. Садофьев, В.П. Мартовицкий, М.А. Базалевский, А.В. Клековкин, Д.В. Аверьянов, И.С. Васильевский; «Гетероструктуры Ge/GeSn, выращенные на Si (100) методом молекулярно-пучковой эпитаксии», ФТП, т. 49, вып. 1, стр. 128 - 133 (2015)
8. Г.Б. Галиев, И.С. Васильевский, Е.А. Климов, А.Н. Клочков, Д.В. Лаврухин, С.С. Пушкарёв, П.П. Мальцев; «Особенности фотолюминесценции НЕМТ-наногетероструктур с составной квантовой ямой InAlAs/InGaAs/InAs/InGaAs/InAlAs», Физика и техника полупроводников, т. 49, вып. 2, стр. 241 - 248 (2015)
9. Г.Б. Галиев, А.Л. Васильев, И.С. Васильевский, Р.М. Имамов, А.Н. Клочков, Д.В. Лаврухин, П.П. Мальцев, С.С. Пушкарёв, И.Н. Трунькин; «Структурные и электрофизические свойства In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As/InP HEMT наногетероструктур с различными комбинациями InAs и GaAs вставок в квантовой яме», Кристаллография, т. 60, вып. 3, стр. 445-454 (2015)
10. G. B. Galiev, I. S. Vasil’evskii, E. A. Klimov, S.S. Pushkarev, Klochkov A.N., Mal’tsev P.P., M.Yu. Presniakov, I.N. Trunkin, A.L. Vasiliev; «Electrophysical and structural properties of the composite quantum wells In0.52Al0.48As/InxGa1-xAs/In0.52Al0.48As with ultrathin InAs inserts», J. Mater. Res., vol. 30, Issue 20, pp 3020-3025 (2015)
11. Мартовицкий В.П., Садофьев Ю.Г., Клековкин А.В., Сарайкин В.В., Васильевский И.С.; «Исследование устойчивости метастабильных эпитаксиальных слоев GeSn к термическим воздействиям», Физика и техника полупроводников, т. 50, вып. 12, стр. 1570 - 1575 (2016)